## §7-4 电容 电容器

#### 一、孤立导体的电容



- •孤立导体是指其它导体或带电体都离它足够远,以至于其它导体或带电体对它的影响可以忽略不计。
- •真空中一个半径为R、带电量为Q的孤立球形导体的电势为

$$U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

电量与电势的比值却是一个常量,只与导体的形 状有关,由此可以引入电容的概念。

# 2 电容的定义

孤立导体所带的电量与 其电势的比值叫做孤立 导体的电容

$$C = \frac{Q}{U}$$

孤立球形导体的电容为

$$C = \frac{Q}{U} = 4\pi\varepsilon_0 R$$

孤立导体的电容与导体的形状有关,与其带电量和电势无关。



#### 电容的单位

法拉(F) 1F=1C.V<sup>-1</sup> 微法 1μF=10<sup>-6</sup>F 皮法 1pF=10<sup>-12</sup>F

# 4

#### 关于电容的说明:

是导体的一种性质,与导体 是否带电无关;

是反映导体储存电荷或电能的能力的物理量;

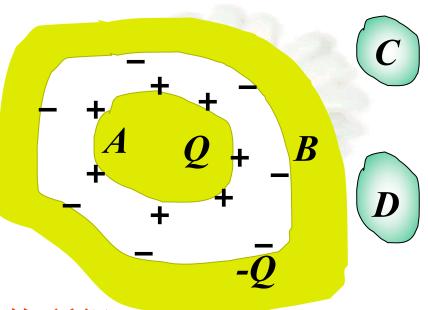
只与导体本身的性质和尺寸 有关。

#### 二、电容器

# 1

#### 电容器的定义

用空腔B将非孤立导体A屏蔽,消除其他导体及带电体(C、D)对A的影响。



两个带有等值而异号电荷的导体所组成的系统,叫做电容器。



#### 电容器的电容

A 带电 Q, B 内表面带电 -Q, 腔内场强E, A B间电势差

$$U_{AB} = U_A - U_B$$

电容器两个极板所带的电量为+Q、-Q,它们的电势分别为 $U_A$ 、 $U_B$ ,定义电容器的电容为:

$$C = \frac{Q}{U_{AB}} = \frac{Q}{U_A - U_B}$$

按可调分类:可调电容器、微调电容器、固定电容器

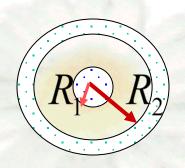
按介质分类: 空气电容器、云母电容器、陶瓷电容器、

纸质电容器、电解电容器

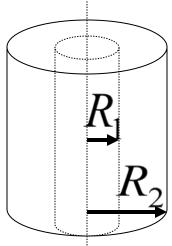
按体积分类: 大型电容器、小型电容器、微型电容器

按形状分类: 平板电容器、圆柱形电容器、球形电容器

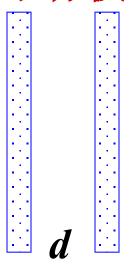
#### 球形



## 柱形



#### 平行板



#### 4

#### 电容器的作用

- •在电路中:通交流、隔直流;
- •与其它元件可以组成振荡器、时间延迟电路等;
- •储存电能的元件;
- •真空器件中建立各种电场;

#### 5

#### 电容器电容的计算

#### 步骤

- 1) 设两极板分别带电  $\pm Q$ ;
- 2) 求 $\bar{E}$ ;
- 3) 求 U;
- **4)** 求 *C*.

#### (1) 平板电容器

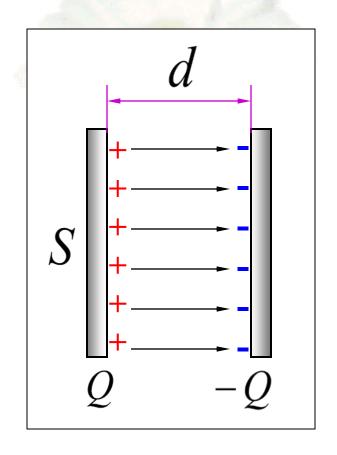
- (1) 设两导体板分别带电  $\pm Q$
- (2) 两带电平板间的电场强度

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$$

(3) 两带电平板间的电势差

$$U = Ed = \frac{Qd}{\varepsilon_0 S}$$

(4) 平板电容器电容



$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

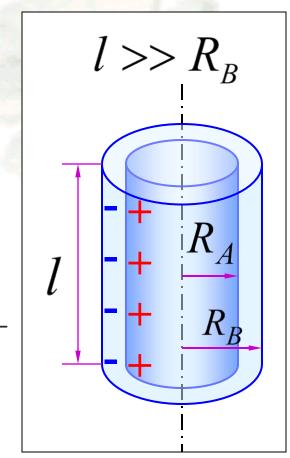
#### (2) 圆柱形电容器

(1) 设两导体圆柱面单位长度上 分别带电土 $\lambda$ 

(2) 
$$E = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 r}$$
,  $(R_A < r < R_B)$ 

(3) 
$$U = \int_{R_A}^{R_B} \frac{\lambda dr}{2\pi \ \varepsilon_0 r} = \frac{Q}{2\pi \ \varepsilon_0 l} \ln \frac{R_B}{R_A}$$

(4) 电容 
$$C = \frac{Q}{U} = 2\pi \varepsilon_0 l / \ln \frac{R_B}{R_A}$$



#### (3) 球形电容器的电容

球形电容器是由半径分别为  $R_1$ 和  $R_2$ 的两同心金属球壳所组成。

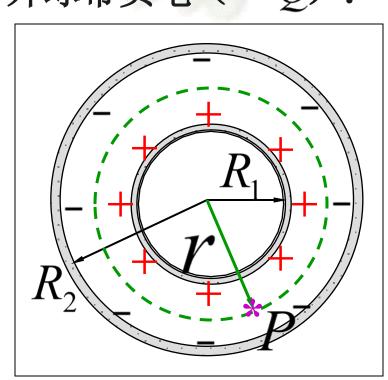
解 设内球带正电 (+Q) ,外球带负电 (-Q) .

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi \ \varepsilon_0 r^2} \vec{e}_{\rm r} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$U = \int_{l} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_{0}} \int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{dr}{r^{2}}$$
$$= \frac{Q}{4\pi \varepsilon_{0}} \left(\frac{1}{R_{1}} - \frac{1}{R_{2}}\right)$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{4\pi\varepsilon_{0}R_{1}R_{2}}{R_{2} - R_{1}}$$

$$R_2 \to \infty$$
,  $C = 4\pi \ \varepsilon_0 R_1$ 



#### 孤立导体球电容

# 例 两半径为R的平行长直导线中心间距为d,且 d >> R,求单位长度的电容.

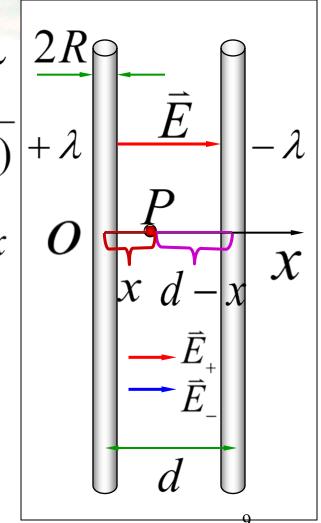
解 设两金属线的电荷线密度为  $\pm \lambda$  2R

$$E = E_{+} + E_{-} = \frac{\lambda}{2\pi} \frac{\lambda}{\varepsilon_{0} x} + \frac{\lambda}{2\pi} \frac{\lambda}{\varepsilon_{0} (d - x)} + \lambda$$

$$U = \int_{R}^{d - R} E dx = \frac{\lambda}{2\pi} \int_{R}^{d - R} (\frac{1}{x} + \frac{1}{d - x}) dx$$

$$= \frac{\lambda}{\pi} \ln \frac{d - R}{R} \approx \frac{\lambda}{\pi} \ln \frac{d}{R}$$

单位长度的电容 
$$C = \frac{\lambda}{U} = \pi \varepsilon_0 / \ln \frac{d}{R}$$



#### 三、电容器的并联和串联



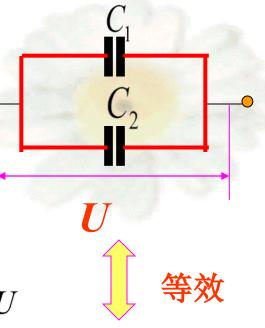
#### 电容器的并联

#### 特点:

每个电容器两端的电势差相等

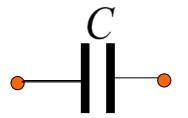
#### 总电量:

$$Q = Q_1 + Q_2 = C_1 U + C_2 U = (C_1 + C_2)U$$



等效电容:

$$C = \frac{Q}{U} = C_1 + C_2$$



#### 结论:

- · 当几个电容器并联时,其等效电容等于几个电容器电容之和;
- •各个电容器的电压相等;
- •并联使总电容增大。



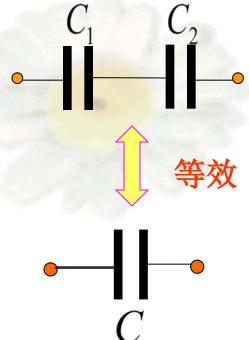
### 电容器的串联

#### 特点

每个电容器极板所带的电量相等

#### 总电压

$$U = U_1 + U_2 = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)Q$$



#### 等效电容

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} \qquad \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

#### 结论:

- •当几个电容器串联时,其等效电容的倒数等于几个电容器电容的倒数之和;
- •每个串联电容的电压与电容成反比
- ·等效电容小于任何一个电容器的电容,但可以提高电容的耐压能力;。

讨论

$$C = \sum_{i} C_{i}$$

$$\frac{1}{C} = \sum_{i} \frac{1}{C_{i}}$$

并联电容器的电容等于各个电容器电容的和。

串联电容器总电容的倒数等于各串联电容倒数之和。

串联使用可以提高<mark>耐压能力</mark> 并联使用可以提高容量

电介质的绝缘性能遭到破坏,称为击穿。所能承受的不被击穿的最大场强叫做击穿场强或介电强度。

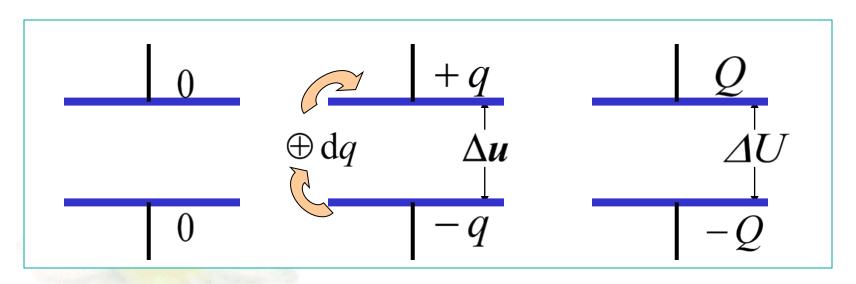
#### §7-5 静电场的能量

#### 一. 电容器的能量

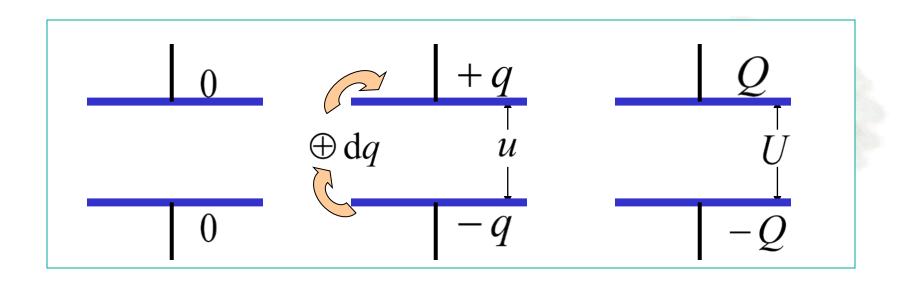
电容器(储能元件)储能多少?

模型: 极板电量  $^{0}\rightarrow Q$  板间电压  $^{0}\rightarrow \Delta U$ 

将 Q 由负极移向 正极板的过程



储能 = 过程中反抗电场力的功。



计算: 
$$dA = u \cdot dq = \frac{q}{C} dq$$

$$A = \int dA = \int_0^{\varrho} \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2C}$$

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}C(U)^2 = \frac{1}{2}QU$$

### 电场的能量

#### 1. 电场能量密度

以平行板电容器为例

$$C = \frac{\varepsilon S}{d}$$
  $U = Ed$ 

$$W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon S}{d} \cdot (Ed)^2 = \frac{1}{2}\varepsilon(Sd) \cdot E^2 = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 \cdot V$$

电场的能量密度 
$$w_e = \frac{W}{V} = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{1}{2}ED$$

#### 2. 电场的能量

$$W = \int_{V} w_{e} dV = \int_{V} \frac{1}{2} E D dV = \int_{V} \frac{1}{2} \varepsilon E^{2} dV$$

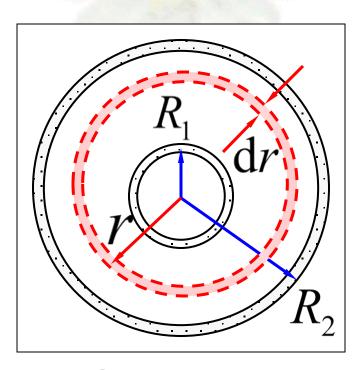
例1 如图所示,球形电容器的内、外半径分别为  $R_1$  和  $R_2$ ,所带电荷为  $\pm Q$ . 若在两球壳间充以电容率为  $\mathcal{E}$  的电介质,问此电容器贮存的电场能量为多少?

$$\mathbf{\tilde{E}} = \frac{1}{4\pi \, \varepsilon} \frac{Q}{r^2} \vec{e}_r$$

$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{Q^2}{32\pi^2 \, \varepsilon r^4}$$

$$dW_{e} = w_{e}dV = \frac{Q^{2}}{8\pi \ \varepsilon r^{2}} dr$$

$$W_{\rm e} = \int dW_{\rm e} = \frac{Q^2}{8\pi \ \varepsilon} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q^2}{8\pi \ \varepsilon} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$



$$W_{e} = \frac{Q^{2}}{8\pi\varepsilon} \left(\frac{1}{R_{1}} - \frac{1}{R_{2}}\right) = \frac{1}{2} \frac{Q^{2}}{4\pi\varepsilon \frac{R_{2}R_{1}}{R_{2} - R_{1}}}$$

讨论

(1) 
$$W_{\rm e} = \frac{Q^2}{2 C}$$

$$C = 4\pi \varepsilon \frac{R_2 R_1}{R_2 - R_1}$$

(球形电容器电容)

(2) 
$$R_2 \to \infty$$

$$W_{\rm e} = \frac{Q^2}{8\pi \ \varepsilon R_1}$$

(孤立导体球贮存的能量)